

判決年月日	平成24年8月8日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成23年(行ケ)第10358号		
<p>○「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を有する引用発明を、本願発明に係る「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、増磁電流と減磁電流を流すために用いられるH型ブリッジ回路とした引用発明の基本構成が変更され、減磁電流を流すことができなくなり、引用発明の課題を解決することができなくなるから、このような変更には阻害要因があるとして、容易に発明することができるとした審決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法29条2項

本件は、発明の名称を「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」とする発明に係る拒絶査定不服審判請求についてされた請求不成立審決の取消訴訟である。

本件審決は、本願発明の「保護回路が2つの半導体スイッチを有しており」という構成は、①「保護回路が半導体スイッチを2つ以上有しており」(解釈1)という構成と、②「保護回路が半導体スイッチを2つのみ有しており」(解釈2)という構成の2通りに解釈することができるとした上、いずれによっても、本願発明は、引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであると判断した。

本判決は、以下のとおり判示して、本件審決を取り消した。

本願発明の特許請求の範囲には、「2つの半導体スイッチ」と記載され、本願明細書の発明の詳細な説明にも、2つの半導体スイッチ(トランジスタ)がある場合の実施例が記載されており、それを超える数の半導体スイッチがある場合についての記載はない。したがって、本願発明は、保護回路が2つの半導体スイッチを有しているのであって、保護回路が2つ以上の半導体スイッチを有していることを前提とする解釈1は、保護回路が2つのみの半導体スイッチを有していることを前提とする解釈2と別個に判断する必要がなく、あえて解釈1に基づく判断をした本件審決の認定判断は、その点において、誤りである。

なお、本願発明について、保護回路が半導体スイッチを2つ以上有していると解釈したとしても(解釈1)、…仮に引用発明に被告のいう技術常識を適用し、界磁巻線(又は半導体スイッチ)に並列にダイオードを接続して、界磁巻線に発生する過電圧を急速に低減させて、界磁巻線に流れる電流を遮断するように構成しても、永久磁石によって生じる磁界により発電機出力が発生するから、発電機の出力電圧の過電圧を低減させることはできず、本願発明にいう「過電圧保護」にはならない。よって、解釈1に基づく本件審決の判断は、誤りである。

また、解釈 2 の場合も、引用発明の「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、増磁電流と減磁電流を流すために用いられるH型ブリッジ回路とした引用発明の基本構成が変更され、減磁電流を流すことができなくなり、引用発明の課題を解決することができなくなるから、…このような変更には阻害要因がある。そして、4つのスイッチング素子を用いる引用発明に対して、スイッチング素子の数を変更することなく周知例 2 に記載された周知技術を適用すると、4つのスイッチング素子に4つのダイオードが逆方向に並列接続される構成になり、解釈 2 に係る本願発明（保護回路が半導体スイッチを2つのみ有しているもの）の構成とならないことは明らかである。よって、解釈 2 に基づく本件審決の判断は、誤りである。